

Изобретение относится к средствам получения материалов покрытия для полупроводниковых приборов, которые работают в ближний и средний ИК-области спектра. Оптическое покрытие на основе сложного халькогенидного стекла для покрытия приборов полупроводниковой фотоники образовано из стеклообразного сплава многокомпонентной системы  $\text{Ge(Pb)-Sb(Bi,Ga)-S(Se)}$ , который не содержит летучих токсичных компонентов. В способе нанесения оптического покрытия на основе халькогенидного стекловидного сплава используют отобранные кусочки халькогенидного стекла для нанесения на предварительно нагретый до необходимой температуры полупроводниковый элемент. Измельченные кусочки халькогенидного стекла помещают в кварцевый реактор, массу халькогенидного стекла, внутренний диаметр конусообразной нижней части кварцевого реактора и размеры оптического покрытия согласовывают между собой, причем кварцевый реактор размещен соосно с нагревателем и выполняет вертикальные перемещения через его верхнюю камеру до непосредственного контакта с полупроводниковым элементом, который находится в нижней камере и выполняет горизонтальные перемещения, температуру верхней камеры нагревателя поддерживают не меньше, чем на  $100^{\circ}\text{C}$  выше температуры размягчения халькогенидного стекла, а температуру нижней камеры нагревателя поддерживают не меньше, чем на  $10^{\circ}\text{C}$  ниже температуры расплавления припоя электрических контактов полупроводникового элемента. Изобретение обеспечивает повышение технологичности нанесения оптического покрытия.

.